

БКО.348.422-02 ТУ

K573PФ2**16К (2Кх8) РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ С
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СТИРАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ***NМОП технология*

Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство с УФ-стиранием информации обеспечивает возможность долговременного хранения информации при включенном и отключенном питании.

- время выборки адреса 450нс;
- напряжение питания $5В \pm 5\%$;
- напряжение сигнала записи-считывания в момент программирования $24,5В \pm 0,5В$;
- допустимое значение статического потенциала не более 200В.

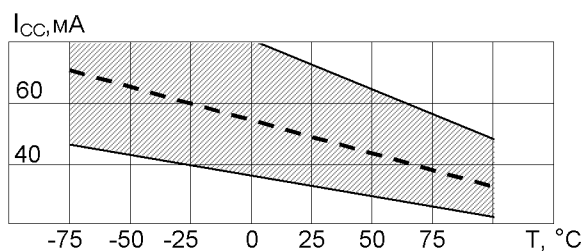
**K573PФ2**

Корпус 210Б.24-5,
210Б.24-5Н,
210Б.24-5НБ

Высота 6 мм
Дл. выводов 3,5 мм
Масса не более 5 г.

НАДЕЖНОСТЬ

| | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| Наработка, ч | $t_{и}$ | 50 000 |
| Интенсивность отказов 1/ч | $\lambda_{и}$ | $1 \cdot 10^{-6}$ |
| Срок хранения, лет | $t_{хр}$ | 12 |

ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ I_{CC} ОТ T**НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

| | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1- 8, 19, 22, 23 | A1-A11 | Вход адресный |
| 9 -11, 13 -17 | D1-D8 | Вход-выход |
| 12 | OV | Общий |
| 18 | $U_{\overline{CE}}$ | Вход сигнала разрешения обращения |
| 20 | $U_{\overline{OE}}$ | Вход сигнала разрешения выхода |
| 21 | WR/RD | Вход сигнала записи-считывания |
| 24 | U_{CC} | Источник питания |

ДОПУСТИМЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ**МЕХАНИЧЕСКИЕ**

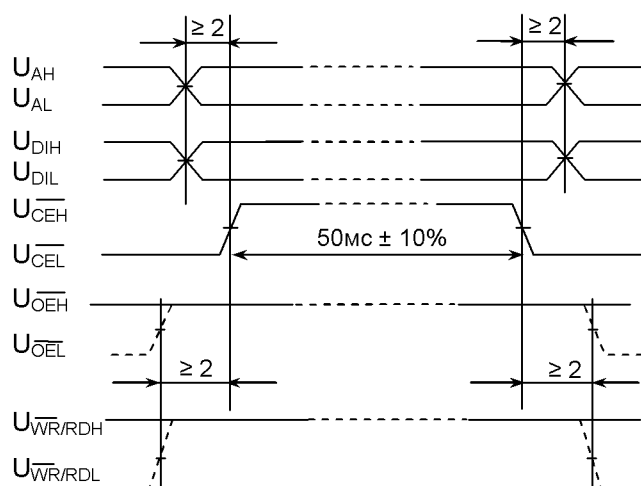
| | |
|---|-----|
| Механические удары, g | 150 |
| Линейное ускорение, g | 500 |
| Вибрация 1 - 2 000 Гц, g | 20 |
| Устойчивость к воде и спирто-бензиновой смеси | 1:1 |

КЛИМАТИЧЕСКИЕ

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от - 45 до 70 |
| Изменение температуры среды, °C | от - 60 до 85 |
| Повышенная влажность при T = 35 °C, % | до 98 |
| Температура пайки, °C | 235 ± 5 |
| Продолжительность, с | $2 \pm 0,5$ |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ($U_{CC} = 5 \text{ В} \pm 5\%$)

| Символ | Параметр | T, °C | K573PФ2 |
|--------------|---|----------------|----------------------------|
| U_{DOL} | Напряжение выхода низкого уровня, В ($I_{OL} = 2,1 \text{ мА}$) | 25, - 45 70 | $\leq 0,40$ $\leq 0,45$ |
| U_{DOH} | Напряжение выхода высокого уровня, В ($I_{OH} = 0,4 \text{ мА}$) | от - 45 до 70 | $\geq 2,4$ |
| I_{CC} | Ток потребления в режиме считывания, мА | 25, 70 - 45 | ≤ 80 ≤ 100 |
| I_{CCS} | Ток потребления в режиме хранения, мА | 25, 70 -45 | ≤ 20 ≤ 25 |
| $I_{WR/RD}$ | Ток сигнала записи - считывания, мА | 25, 70 - 45 | ≤ 6 ≤ 10 |
| $I_{WR/RDS}$ | Ток сигнала записи – считывания в режиме хранения, мА | от - 45 до 70 | ≤ 2 |
| I_{LI} | Ток утечки по каждому входу, мкА | от - 45 до 70 | ≤ 10 |
| $t_{A(A)}$ | Время выборки адреса, мкс | от - 45 до 70 | $\leq 0,45$ |
| $t_{A(CE)}$ | Время выборки разрешения обращения, мкс | от - 45 до 70 | $\leq 0,45$ |
| $t_{A(OE)}$ | Время выборки разрешения выхода, мкс | от - 45 до 70 | $\leq 0,20$ |
| t_{SG1} | Время хранения информации при отключённом питании, ч | от - 45 до 70 | $\geq 100\ 000$ |
| t_{SG2} | Время хранения информации при включённом питании, ч | от - 45 до 70 | $\geq 50\ 000$ |
| C_I | Входная ёмкость выводов микросхем, пФ | 25 ± 10 | ≤ 8 |
| N_{CY} | Количество циклов перепрограммирования, цикл | 25 ± 10 | ≥ 100 |

ДИАГРАММА РЕЖИМА ЗАПИСИ


Допускается объединение микросхем по входам и выходам.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки или паяльником.

Стирание информации проводят путём воздействия потока ультрафиолетового излучения длиной волны $\lambda=253,7 \text{ нм}$, с энергетической экспозицией $1,5 \cdot 10^5 \text{ Вт} \cdot \text{с}/\text{м}^2$.

Ток потребления от сигнала записи-считывания ($I_{WR/RDH}$) в момент программирования может достигать 30 мА (импульсный), а в режиме запрета программирования или контроля после программирования – не более 6,0 мА.